

850nm 25Gbps GaAs PD Chip $\phi 40\mu\text{m}$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 25Gbps/通道； $\phi 40\mu\text{m}$ 有效面积；850nm 高响应度；正面阳极/阴极焊盘

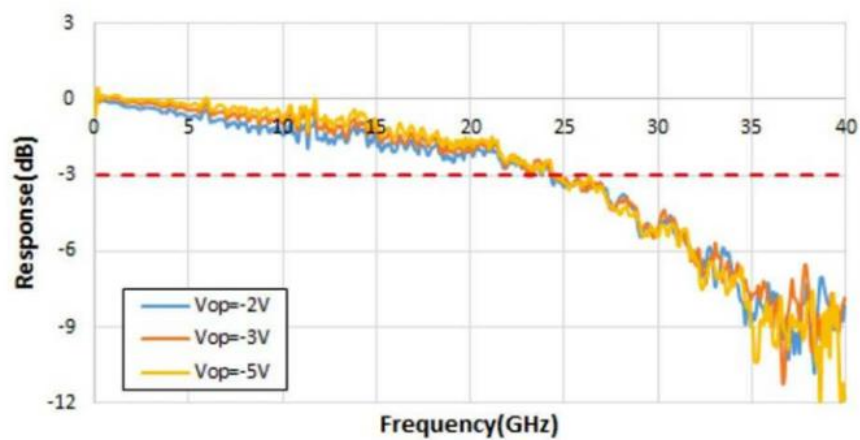
应用领域

25G-100G SR4 AOC | 4x25Gbps 光纤通道 | 100Gbps QSFP | 短距离光纤网络

核心参数

无
无

详细参数



规格 ($T_c=25^{\circ}C$, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_D		0.01	0.05	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.085	0.12	pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		22		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		40		μm	
通道之间的中心间距(pitch)			250		μm	